

**B****DF-2988****Second Year B. Sc. (CBCS) (Sem. III) Examination****March / April - 2016****Physics : Paper - V**

Time : 2 Hours]

[Total Marks : 50

**સૂચના/Instructions :**

(1)

નીચે દર્શાવેલ નિશાનીવાળી વિગતો ઉત્તરવહી પર અવશ્ય લખવી. Fillup strictly the details of signs on your answer book.	Seat No. :
Name of the Examination :	<input type="text"/>
<input type="text" value="SECOND YEAR B. Sc. (CBCS) (SEM. 3)"/>	<input type="text"/>
Name of the Subject :	<input type="text"/>
<input type="text" value="PHYSICS : PAPER - 5"/>	<input type="text"/>
Subject Code No. : <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text"/>
Section No. (1, 2,.....) : <input type="text" value="Nil"/>	<input type="text"/>
	Student's Signature

- (૨) નોનપ્રોગ્રામેબલ સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છે.
- (2) Non-programmable scientific calculator can be used.
- (૩) પ્રશ્નપત્રમાં ઉપયોગમાં લીધેલી સંજ્ઞાઓ પ્રચલિત અર્થમાં છે.
- (3) Notations used in the question paper are as usual meaning.

**Q. 1 to 12 Multiple Choice Questions are each of 1 Mark**

**Q. 13 to 22 Multiple Choice Questions are each of 2 Marks**

**Q. 23 to 28 Multiple Choice Questions are each of 3 Marks**

***O.M.R. Sheet ભરવા અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ આપેલ  
O.M.R. Sheet-ની પાછળ છાપેલ છે.***

***Important instructions to fillup O.M.R. Sheet  
are given on back side of the provided O.M.R. Sheet.***

1 થેવેનીન અવરોધ  $R_{TH}$  અને નોર્ટન અવરોધ  $R_N$  વચ્ચેનો સાચો ગાણિતિક સંબંધ \_\_\_\_\_.

The true mathematical relation between Thevenin resistance  $R_{TH}$  & Norton's resistance  $R_N$  is \_\_\_\_\_.

(A) none of these

(B)  $R_{TH} < R_N$

(C)  $R_{TH} = R_{TN}$

(D)  $R_{TH} > R_N$

2 પરિપથનો થેવેનીન વોલ્ટેજ = \_\_\_\_\_.

(A) બોજ (લોડ) વોલ્ટેજ

(B) શોર્ટ પરિપથ વોલ્ટેજ

(C) વીજકોષનું વીજચાલક બળ

(D) બે છેડા વચ્ચે મળતો ઓપન પરિપથ વોલ્ટેજ

Thevenin voltage of a circuit equals \_\_\_\_\_.

(A) Load voltage

(B) Short-terminal voltage

(C) EMF of the battery

(D) Open circuit terminal voltage

3 વોલ્ટેજ વિભાજક બાયસિંગ પરિપથનો ગેરફાયદો \_\_\_\_\_.

- (A) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
- (B) ઉચ્ચ સ્થાયિત્વ અંક
- (C) ખૂબ ઓછો બેઈઝ પ્રવાહ
- (D) ઘણા અવરોધો

The disadvantage of voltage divider bias is that it has \_\_\_\_\_.

- (A) None of these
- (B) high stability factor
- (C) low base current
- (D) many resistors

4 JFET \_\_\_\_\_ વાલ્વની જેમ વર્તે છે.

- (A) ટેટ્રોડ
- (B) ડાયોડ
- (C) પેન્ટોડ
- (D) ટ્રાયોડ

A JFET is similar in operation to \_\_\_\_\_ valve.

- (A) tetrode
- (B) diode
- (C) pentode
- (D) triode

5 જો તાપમાન વધે તો  $V_{BE}$  નું મૂલ્ય \_\_\_\_\_.

- (A) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
- (B) સમાન રહે છે
- (C) વધે છે
- (D) ઘટે છે

If the temperature increases, the value of  $V_{BE}$  \_\_\_\_\_.

- (A) None of these
- (B) remains the same
- (C) is increased
- (D) is decreased

6 એક એ.સી. પરિપથમાં એક સેકન્ડમાં 120 વખત પ્રવાહ શૂન્ય થતો હોય તો એ.સી. પ્રવાહની આવૃત્તિ કેટલી ?

In one A.C. network current becomes zero 120 times in one second, then what is the frequency of A.C. current ?

- (A) 60 Hz
- (B) 120 Hz
- (C) 1 Hz
- (D) 200 Hz

7 જ્યારે એ.સી. બ્રિજનું સંતુલન થાય ત્યારે ડીટેક્ટરમાંથી વહેતો પ્રવાહ \_\_\_\_\_ A.

(A) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ

(B) અનંત

(C) શૂન્ય

(D) એક

When A.C. bridge is balanced, current flowing through detector is \_\_\_\_ A.

(A) None of these

(B) infinity

(C) zero

(D) 1

8 L-C-R શ્રેણી પરિપથમાં જો L, C અને R ના બે છેડાઓ વચ્ચે ઉદ્ભવતો વીજસ્થિતિમાન તફાવત અનુક્રમે  $V_L$ ,  $V_C$  અને  $V_R$  હોય તો એ.સી. ઉદ્ગમનો વોલ્ટેજ \_\_\_\_\_.

In an L-C-R series network, the voltage difference across the two terminals of L, C & R are  $V_L$ ,  $V_C$  &  $V_R$  respectively, then the voltage of A.C. source is \_\_\_\_\_.

(A)  $\sqrt{V_R^2 + (V_L + V_C)^2}$

(B)  $V_L + V_R - V_C$

(C)  $V_L - V_R + V_C$

(D)  $V_L + V_C + V_R$

9 સામાન્ય રીતે, અવરોધ અને આદર્શ તથા અચળ એવા સંગ્રાહકના પદમાં અજ્ઞાત પ્રેરણ માપવા \_\_\_\_\_ વપરાય છે.

- (A) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
- (B) એન્ડરસન બ્રિજ
- (C) ઓવન બ્રિજ
- (D) મેક્સવેલ બ્રિજ

Generally, \_\_\_\_\_ is used to measure unknown inductance in terms of resistance & a standard fixed capacitor.

- (A) none of these
- (B) Anderson's bridge
- (C) Owen's bridge
- (D) Maxwell's bridge

10 સમાંતર અનુનાદી પરિપથમાં અનુનાદ વખતે પરિપથનો અવભાધ \_\_\_\_\_.

- (A) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
- (B) અનંત
- (C) શૂન્ય
- (D) એક

In parallel resonant circuit, at resonance the impedance of the circuit is \_\_\_\_\_.

- (A) none of these
- (B) infinity
- (C) zero
- (D) one

11 જે પરિપથમાં બિનજરૂરી આવૃત્તિવાળો પ્રવાહ પસાર ના થઈ શકે તે \_\_\_\_\_ .

- (A) ફિલ્ટર
- (B) સમાંતર અનુનાદી પરિપથ
- (C) એસેપ્ટર
- (D) શ્રેણી અનુનાદી પરિપથ

The circuit in which currents of unwanted frequencies are not allowed to pass is \_\_\_\_\_.

- (A) filter
- (B) parallel resonant circuit
- (C) acceptor
- (D) series resonance circuit

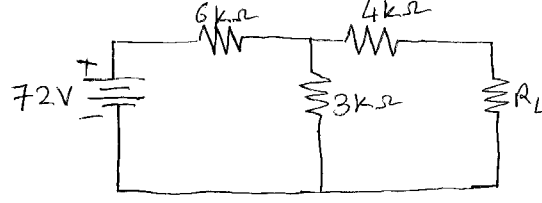
12 અક્કડ (stiff) વોલ્ટેજ ઉદ્ભવ માટેની શરત \_\_\_\_\_.

The condition for stiff voltage source is \_\_\_\_\_.

- (A)  $R_s < 0.01 R_L$
- (B)  $R_s = 0.01 R_L$
- (C)  $R_s = 0.001 R_L$
- (D)  $R_s > 0.01 R_L$

13 આપેલા પરિપથ માટે  $V_{TH}$  અને  $R_{TH}$  માટેનાં મૂલ્યો શોધો.

For given circuit find  $V_{TH}$  &  $R_{TH}$ .



- (A) None of these
- (B) 24V, 5.33 k $\Omega$
- (C) 12V, 5.33 k $\Omega$
- (D) 24V, 6 k $\Omega$

14 CE ટ્રાન્ઝિસ્ટર પરિપથમાં કલેક્ટર ફીડબેક પદ્ધતિ વડે બાયસિંગ આપીને પરિચાલન બિંદુ (2V, 1mA) મેળવેલ છે. જો  $\beta=100$  &  $V_{BE}=0.7V$  તો  $R_B=$  \_\_\_\_\_.

By using biasing with collector feedback method, a transistor in CE configuration the operating point is set at (2V, 1mA). If  $\beta=100$  and  $V_{BE}=0.7V$  then  $R_B=$  \_\_\_\_\_.

- (A) 1.3k $\Omega$
- (B) 130 $\Omega$
- (C) 1300 $\Omega$
- (D) 130k $\Omega$



- 15 એક CE VDB પરિપથ Ge ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી બનાવેલ છે. જો  $\alpha = 0.985$ ,  $V_{CC} = 16\text{ V}$ ,  $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 2\text{ k}\Omega$  અને પરિચાલન બિંદુ  $(2\text{ V}, 1\text{ mA})$  હોય તો  $R_2$  આડે મળતો વોલ્ટેજ જણાવો.

In CE germanium transistor VDB circuit,  $\alpha = 0.985$ ,  $V_{CC} = 16\text{ V}$ ,  $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 2\text{ k}\Omega$  and operating point is  $(2\text{ V}, 1\text{ mA})$ . Give the value of Voltage across  $R_2$ .

- (A) None of these
- (B) 4.3 V
- (C) 4 V
- (D) 11.7 V
- 16 JFET નો  $I_{DSS} = 12\text{ mA}$ ,  $V_{GS} = -4\text{ V}$  and  $V_{GS(\text{off})} = -5\text{ V}$  તો  $I_D = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- JFET has  $I_{DSS} = 12\text{ mA}$ ,  $V_{GS} = -4\text{ V}$  &  $V_{GS(\text{off})} = -5\text{ V}$  then  $I_D = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- (A) None of these
- (B) 0.48 mA
- (C) 0.24 mA
- (D) 17 mA

17 પ્રવાહ સોર્સ બાયસ JFET પરિપથ માટે  $V_{DD} = 10V$ ,  $V_{EE} = 5V$ ,  
 $R_D = 1k\Omega$ ,  $R_G = 1M\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7V$  &  $R_E = 2k\Omega$ , ડ્રેઈન વોલ્ટેજ =  
\_\_\_\_\_ .

In a current source bias JFET circuit,  $V_{DD} = 10V$ ,  $V_{EE} = 5V$ ,  
 $R_D = 1k\Omega$ ,  $R_G = 1M\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7V$  &  $R_E = 2k\Omega$ , then the drain voltage  
is \_\_\_\_\_ .

- (A) 5 V
- (B) 4.3 V
- (C) 7.85 V
- (D) 15 V

18 એક L-C-R શ્રેણી પરિપથ માટે  $V = 100$  volts,  $R = 1\Omega$ ,  $L = 1H$  &  $C = 7.04\mu F$ ,  
તો આ પરિપથમાં મહત્તમ પ્રવાહ કેટલો ?

In a series L-C-R circuit,  $V = 100$  volts,  $R = 1\Omega$ ,  $L = 1H$  &  $C = 7.04\mu F$ .  
Then what will be the maximum current in the circuit ?

- (A) 10 mA
- (B) 10 A
- (C) 100 A
- (D) 10  $\mu A$

- 19 એક L-C-R પરિપથમાં L અને R ને શ્રેણીમાં જોડેલ છે તથા C તેની સાથે સમાંતરમાં જોડેલ છે. જો  $L=1 \text{ H}$ ,  $C=10 \mu\text{F}$ ,  $R=100 \Omega$  અને એ.સી. ઉદ્દગમ  $220\text{V}$   $50\text{Hz}$  નો હોય, પરિપથનો અવબાધ મહત્તમ થાય ત્યારે  $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$  rad/sec.

In one L-C-R circuit L & R are connected in series and C is connected in parallel with combination. If  $L=1 \text{ H}$ ,  $C=10 \mu\text{F}$ ,  $R=100 \Omega$  & A.C. supply is of  $220\text{V}$   $50\text{Hz}$  Then the impedance is maximum for  $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$  rad/sec.

- (A) None of these
- (B) 316
- (C) 300
- (D) 157
- 20  $L = 0.2 \text{ H}$ ,  $R = 10 \Omega$  &  $C = 10 \mu\text{F}$  ના શ્રેણી અનુનાદી પરિપથને  $200\text{V}$ ,  $50\text{Hz}$  ના એસી ઉદ્દગમ સાથે જોડેલ છે, તો પરિપથનો અવબાધ  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

In a series resonant circuit  $L = 0.2 \text{ H}$ ,  $R = 10 \Omega$  &  $C = 10 \mu\text{F}$  are connected with A.C. supply of  $200\text{V}$ ,  $50\text{Hz}$ . The impedance of circuit  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

- (A)  $255 \Omega$
- (B)  $32.6 \Omega$
- (C)  $390 \Omega$
- (D)  $380 \Omega$

21  $C=12.5\mu\text{F}$  ના કેપેસિટરનો 60 Hz આવૃત્તિ માટે અવબાધ \_\_\_\_\_.

The capacitive reactance of  $C=12.5\mu\text{F}$  with  $f = 60$  Hz is \_\_\_\_\_.

(A)  $4650\Omega$

(B)  $4.71\text{m}\Omega$

(C)  $121\Omega$

(D)  $212\Omega$

22 એક મેક્સવેલ બ્રિજની AB શાખામાં  $45\Omega$  ના અવરોધનું અજ્ઞાત પ્રેરણ  $L_1$  સાથે શ્રેણીમાં, BC શાખામાં  $290\Omega$  નો અવરોધ, CD શાખામાં  $0.8\mu\text{F}$  ના કેપેસિટર ને  $580\Omega$  ના અવરોધ સાથે સમાંતરમાં, AD શાખામાં  $90\Omega$  નો અવરોધ જ્યારે B અને D વચ્ચે ડીટેક્ટર જોડેલ છે તથા A અને C વચ્ચે એ.સી. ઉદ્દગમ જોડેલ છે, તો બ્રિજ સંતુલન વખતે  $L_1 =$  \_\_\_\_\_.

In a Maxwell bridge a resistance of  $45\Omega$  is connected in series with unknown inductance  $L_1$  in branch AB, resistance  $290\Omega$  is connected in branch BC, in branch CD there is a parallel combination of capacitor & resistance of values  $0.8\mu\text{F}$  &  $580\Omega$  respectively. In branch AD there is resistance of  $90\Omega$  and a detector is connected between B & D. Also A.C. voltage source is connected between A & C. Find  $L_1$  when bridge is balanced.

(A) 12 H

(B) 21 mH

(C) 12 mH

(D) 11 mH

- 23 એક વાઈન બ્રિજ પરિપથ ABCD નીચે મુજબ બનાવેલ છે. AB શાખા  $200\Omega$ , ના અવરોધ સાથે  $1\mu\text{F}$  ના કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ, BC શાખા  $400\Omega$  નો અવરોધ, DC શાખા  $1000\Omega$ નો અવરોધ, અને AD શાખા  $R\Omega$  ના અવરોધ સાથે  $2\mu\text{F}$  ના કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ ધરાવે છે. બિંદુ A અને C વચ્ચે એ.સી.બેટરી તથા બિંદુ B & D વચ્ચે ડીટેક્ટર જોડેલ છે. આ બ્રિજ પરિપથ સંતુલન થાય ત્યારે R અને આવૃત્તિનાં મૂલ્યો શોધો.

The four arms of Wien's bridge ABCD are made up by following data values:

AB branch have  $200\Omega$  resistance in parallel with  $1\mu\text{F}$  capacitor, BC branch has  $400\Omega$  resistance, CD branch has  $1000\Omega$  resistance, AD branch has a resistance R in series with a  $2\mu\text{F}$  capacitor. An A.C. source is connected between point A & C and detector is connected between point B & D. Find the value of R & frequency when bridge is balanced.

- (A)  $100\Omega$  &  $96\text{ Hz}$
- (B)  $400\Omega$  &  $796\text{ Hz}$
- (C)  $200\Omega$  &  $960\text{ Hz}$
- (D)  $100\Omega$  &  $796\text{ Hz}$
- 24 LCR શ્રેણી પરિપથને  $400 \cos(3000t - 10^\circ)\text{V}$  નો વોલ્ટેજ આપવાથી પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ  $10\sqrt{2} \cos(3000t - 55^\circ)\text{A}$  છે. જો  $L = 0.01\text{H}$  તો R અને Cનાં મૂલ્યો કેટલાં?
- In a series LCR circuit, when a voltage of  $400 \cos(3000t - 10^\circ)\text{V}$  is applied, the current flowing is  $10\sqrt{2} \cos(3000t - 55^\circ)$  ampere. If  $L = 0.01\text{H}$  then what are the values of R & C ?
- (A)  $30\Omega, 33.3\mu\text{F}$
- (B)  $30\Omega, 3.33\mu\text{F}$
- (C)  $28\Omega, 3.33\mu\text{F}$
- (D)  $20\Omega, 33.3\mu\text{F}$

25 એક VDB CE (Si) ટ્રાન્ઝિસ્ટર પરિપથમાં  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ,  $R_C = 3.6 \text{ k}\Omega$  અને  $\beta_{dc} = 200$ , તો  
 $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$  અને  $I_E = \underline{\hspace{2cm}}$ .

In VDB CE (Si) transistor circuit,  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ,  $R_C = 3.6 \text{ k}\Omega$  &  $\beta_{dc} = 200$ . Then  
 $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$  &  $I_E = \underline{\hspace{2cm}}$ .

- (A) 11.07 V, 2 A
- (B) 11.07 V, 1 A
- (C) 5.8 V, 2 mA
- (D) 11.07 V, 2 mA

26 અસ્ક્રૂ (stiff) VDB ડિઝાઇન ગાઈડલાઈન અને આપેલાં મૂલ્યો  $V_{CC} = 10 \text{ V}$ ,  $V_{CE} =$   
મધ્યબિંદુ  $I_C = 1 \text{ mA}$  અને  $\beta_{dc} = 70$  થી 200  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$  ની મદદથી :  
 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $R_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  &  $R_E = \underline{\hspace{2cm}}$ .

Using stiff VDB design guidelines & given data values:  $V_{CC} = 10 \text{ V}$ ,  $V_{CE}$  is  
at mid point,  $I_C = 1 \text{ mA}$  &  $\beta_{dc} = 70$  to 200,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$  the values of  
 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $R_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  &  $R_E = \underline{\hspace{2cm}}$ .

- (A) 342  $\Omega$ , 200  $\Omega$ , 150  $\Omega$
- (B) 13.67  $\Omega$ , 280  $\Omega$ , 100  $\Omega$
- (C) 13.67k  $\Omega$ , 2.8k  $\Omega$ , 1k $\Omega$
- (D) 13.67k  $\Omega$ , 280  $\Omega$ , 1k $\Omega$

27 એક JFET માટે  $I_{DSS} = 35 \text{ mA}$ ,  $V_P = 12 \text{ V}$  &  $g_{m0} = 5100 \mu\text{S}$  હોય, તો  $V_{GS} = -6 \text{ V}$  માટે  $I_D$  &  $g_m$  નાં મૂલ્યો \_\_\_\_\_.

A JFET has  $I_{DSS} = 35 \text{ mA}$ ,  $V_P = 12 \text{ V}$  &  $g_{m0} = 5100 \mu\text{S}$ . For  $V_{GS} = -6 \text{ V}$  the values of  $I_D$  &  $g_m$  are \_\_\_\_\_.

- (A) None of these
- (B) 8.75 mA, 255  $\mu\text{S}$
- (C) 8.75 mA, 2550  $\mu\text{S}$
- (D) 7.5 mA, 255  $\mu\text{S}$

28 એક ઢ્રિજ પરિપથ ABCD નીચે મુજબ બનાવેલ છે. બિંદુઓ A અને B, B અને C, C અને D, A અને D તથા B અને D વચ્ચે અનુક્રમે  $10 \Omega$ ,  $30 \Omega$ ,  $15 \Omega$ ,  $20 \Omega$ , અને  $40 \Omega$ , ના અવરોધ આવેલા છે. બિંદુઓ A અને C વચ્ચે અવગણ્ય આંતરિક અરોધ ધરાવતી 2 V ની ડી.સી. બેટરી જોડેલ છે. આ પરિપથ માટે  $V_{TH}$ ,  $R_{TH}$  તથા BD શાખામાંથી વહેતો પ્રવાહ \_\_\_\_\_.

A bridge network ABCD is arranged as follows: Resistance between terminals A & B, B & C, C & D, D & A and B & D are  $10 \Omega$ ,  $30 \Omega$ ,  $15 \Omega$ ,  $20 \Omega$ , &  $40 \Omega$ ., respectively. A 2 V d.c battery of negligible internal resistance is connected between terminals A & C. For this circuit the values of  $V_{TH}$ ,  $R_{TH}$  & current through BD branch are \_\_\_\_\_.

- (A) None of these
- (B) 1.5 V,  $18 \Omega$ , 20A
- (C) 0.86 V,  $16.6 \Omega$ , 11.5A
- (D) 0.645 V,  $16 \Omega$ , 11.5 mA

SPACE FOR ROUGH WORK